

Publication

EP 0137315 A2 19850417 (DE)

Application

EP 84110654 A 19840907

Priority

DE 3334733 A 19830926

Abstract (en)

[origin: US4584015A] Process and system for the production of very pure alloys. The starting materials are first melted and vacuum treated in an induction crucible inside a vacuum melt system, and then are poured into a second melt crucible, and there brought to casting temperature and held there. An opening beneath the melt in the second melt crucible is used for pouring out the melt. The system for carrying out the process comprises a vacuum melt crucible assembly containing an induction melt crucible and a second melt crucible. The second melt crucible has an orifice in its lower area which is operated by a sealing arrangement. A chamber is arranged underneath the second melt crucible.

Abstract (de)

Bei diesem Verfahren werden die Ausgangswerkstoffe nach dem Erschmelzen und der Vakuumbehandlung in einem Induktionstiegel innerhalb einer Vakuumschmelzanlage in einen zweiten Schmelztiegel umgefüllt und dort einer Raffinationsbehandlung unterzogen und auf Gießtemperatur gebracht und gehalten. Zum Abfließen der Schmelze wird eine Öffnung unterhalb der Schmelze benutzt. Im unteren Bereich des zweiten Schmelztiegels kann der Schmelze Inertgas zugeführt werden. Die Anlage zur Durchführung des Verfahrens weist eine Vakuumschmelzanlage (2) mit einem Induktionstiegel (1) und einem zweiten Schmelztiegel (3) auf. Der zweite Schmelztiegel (3) hat in seinem unteren Bereich eine von einer Verschleißanordnung (5) betätigbaren Ausgußöffnung (4). Unterhalb des zweiten Schmelztiegels (3) ist eine Verdüsungskammer (13) angeordnet.

IPC 1-7

B22D 27/15

IPC 8 full level

C22C 1/02 (2006.01); **B22D 23/00** (2006.01); **B22D 27/15** (2006.01); **C21C 5/52** (2006.01); **C21C 7/10** (2006.01); **C22B 9/04** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B22D 27/15 (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

AT BE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0137315 A2 19850417; **EP 0137315 A3 19850821**; **EP 0137315 B1 19880601**; AT E34775 T1 19880615; DE 3334733 A1 19850425; DE 3334733 C2 19850814; JP S6096738 A 19850530; US 4584015 A 19860422

DOCDB simple family (application)

EP 84110654 A 19840907; AT 84110654 T 19840907; DE 3334733 A 19830926; JP 19874284 A 19840925; US 65408784 A 19840925